50A CELL SERIES

硅整流器 **Silicon Rectifier**

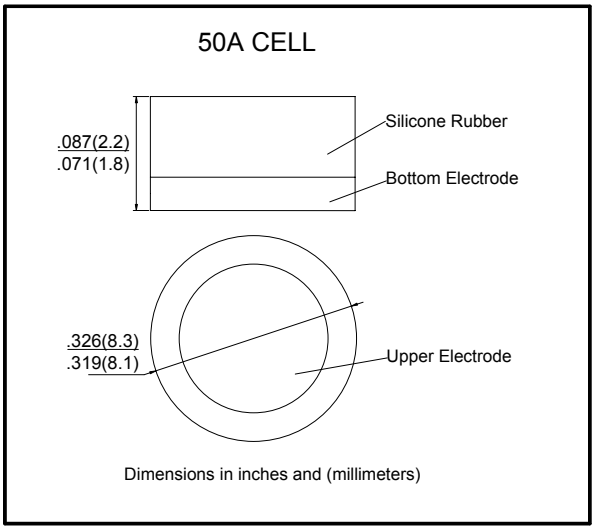
■特征 Features

- I_o 50A
- V_{RRM} 100V~1000V
- 电极表面高可焊性
  Solderable electrode surface
- 耐正向浪涌电流能力高
  High surge forward current capability

■用途 Applications

- 作一般单相整流用
  General purpose 1 phase
  rectifier applications

■外形尺寸和印记Outline Dimensions and Mark



■极限值（绝对最大额定值）

Limiting Values（Absolute Maximum Rating）

参数名称 Item	符号 Symbol	单位 Unit	条件 Conditions	50A					
				100V	200V	400V	600V	800V	1000V
反向重复峰值电压 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	V		100	200	400	600	800	1000
平均整流输出电流 Average Rectified Output Current	I_O	A	60Hz 正弦波，电阻负载，T_a=50℃ 60Hz sine wave, R- load, T_a=50℃	50					
正向（不重复）浪涌电流 Surge(Non-repetitive)Forward Current	I_{FSM}	A	60Hz正弦波，一个周期，T_a=25℃ 60Hz sine wave, 1 cycle, T_a=25℃	500					
正向浪涌电流的平方对电流浪涌持续时间的积分值 Current Squared Time	I^2t	A^2s	1ms≤t＜8.3ms T_j=25℃,单个二极管 1ms≤t＜8.3ms T_j=25℃,Rating of per diode	1042					
存储温度 Storage Temperature	T_{stg}	℃		-55 ~+150					
结温 Junction Temperature	T_j	℃		-55 ~+125					

■电特性 （Ta=25℃ 除非另有规定）

Electrical Characteristics（T_a=25℃ Unless otherwise specified）

参数名称 Item	符号 Symbol	单位 Unit	测试条件 Test Condition		最大值 Max
正向峰值电压 Peak Forward Voltage	V_{FM}	V	I_{FM}=50A,脉冲测试，单个二极管的额定值 I_{FM}=50A, Pulse measurement, Rating of per diode		1.1
反向峰值电流 Peak Reverse Current	I_{RRM1}	μA	V_{RM}=V_{RRM}	T_a=25℃	5
	I_{RRM2}			T_a=125℃	500
热阻 Thermal Resistance	$R_{\theta J-A}$	℃/W	结和环境之间 Between junction and ambient		1.5

■特性曲线（典型） Characteristics(Typical)

图1：Io-Ta曲线
FIG1:Io-Ta Curve

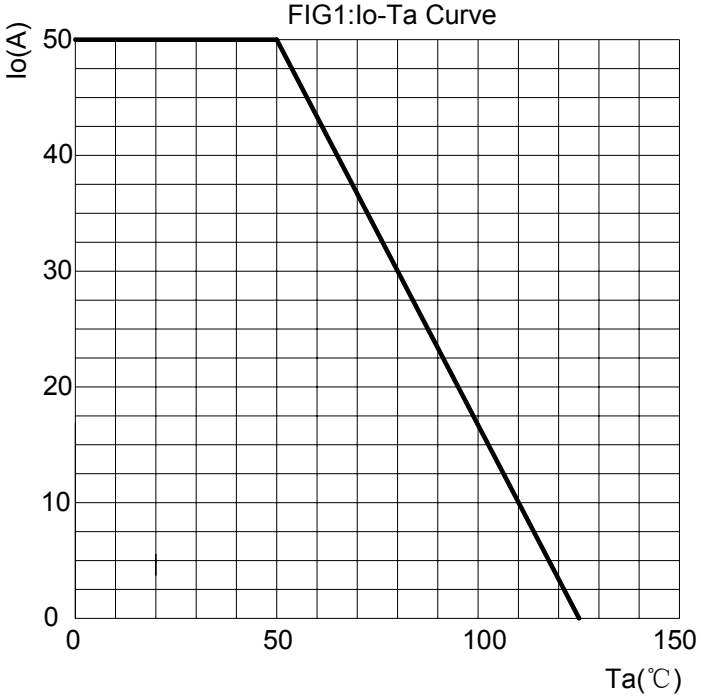


图2：耐正向浪涌电流曲线
FIG2:Surge Forward Current Capadility

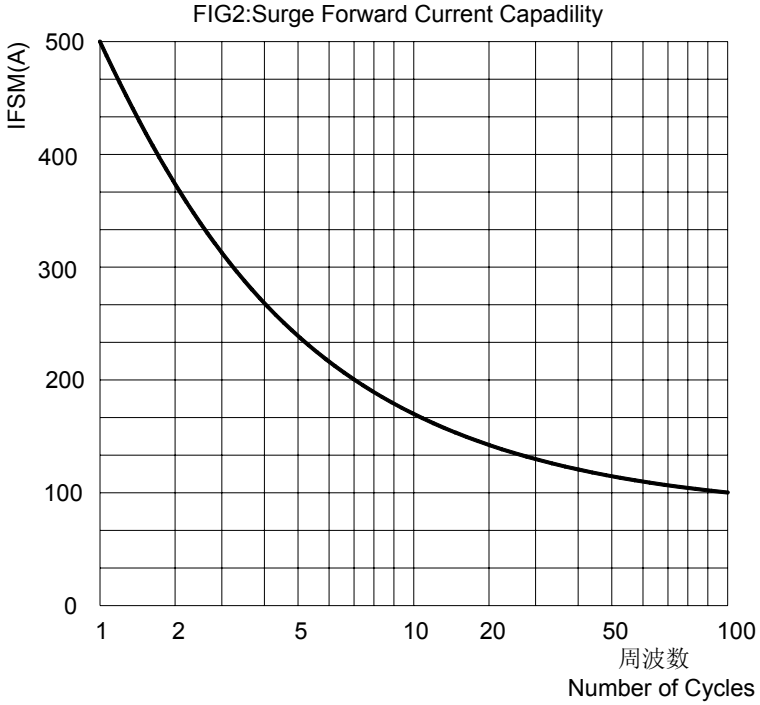


图3：正向电压曲线
FIG3:Instantaneous Forward Voltage

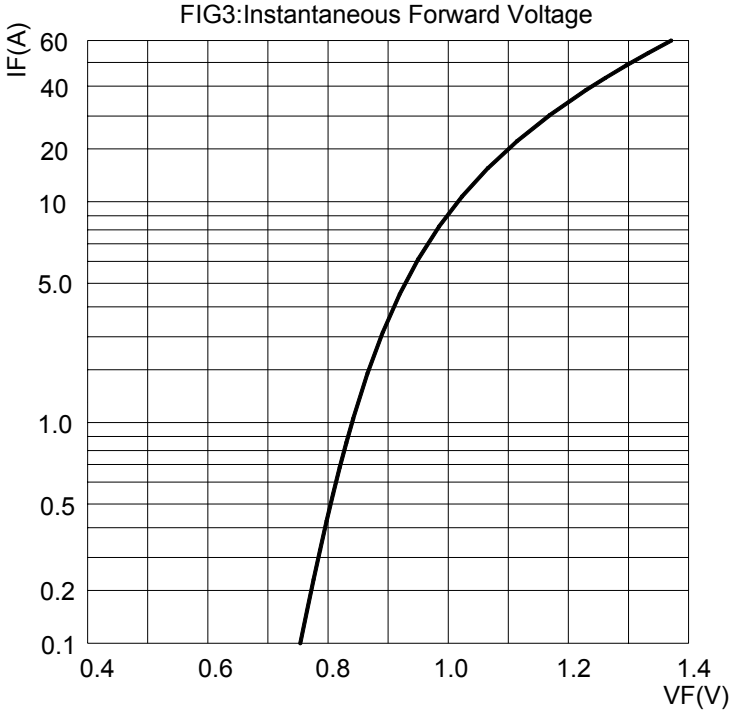


图4：反向电流曲线
FIG4:Typical Reverse Characteristics

